
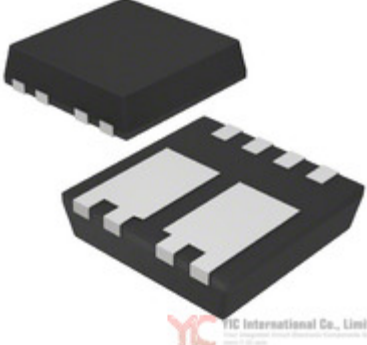



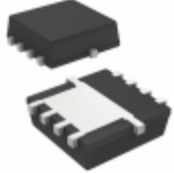

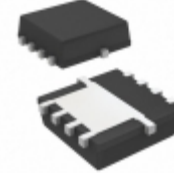
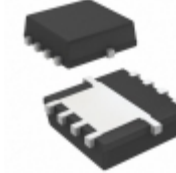



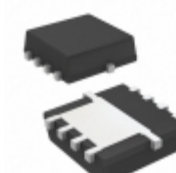
| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">SIS488DN-T1-GE3</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: SIS488DN-T1-GE3 |
| | Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 40A 1212-8 |
| | Datenblätter:  SIS488DN-T1-GE3.pdf |
| | RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, 31167 pcs Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SIS488DN-T1-GE3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 40V 40A 1212-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 31167 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.2V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® 1212-8 |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 5.5 mOhm @ 20A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 3.7W (Ta), 52W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® 1212-8 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1330pF @ 20V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 32nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 40V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 40A (Tc) |

SIS488DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS488DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS488DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIS488DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>SIS478DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A 1212-8</p> |  <p>SIS501NT1G SIG SIG SOT-523</p> |  <p>SIS478DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A 1212-8</p> |  <p>SIS476DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A 1212-8 PWR</p> |
|  <p>SIS496EDNT-T1-GE3 VISHAY VISHAY DFN</p> |  <p>SIS496EDNT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 50A POWERPAK1212</p> |  <p>SIS502NT1G SIG SIG SOD723</p> |  <p>SIS476DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A 1212-8 PWR</p> |

SIS488DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| SIS488DN-T1-GE3 | Vishay / Siliconix | SIS488DN-T1-GE3 Datenblatt | SIS488DN-T1-GE3-Datenblätter | SIS488DN-T1-GE3 PDF | Vishay / Siliconix SIS488DN-T1-GE3 |
| SIS488DN-T1-GE3 Electronic | | SIS488DN-T1-GE3-Komponenten | SIS488DN-T1-GE3-Verteiler | SIS488DN-T1-GE3-Bild | SIS488DN-T1-GE3-Teil |
| SIS488DN-T1-GE3 Preis | | SIS488DN-T1-GE3 Hersteller | SIS488DN-T1-GE3 Bild | SIS488DN-T1-GE3 Aktie | SIS488DN-T1-GE3 Inventar |
| SIS488DN-T1-GE3 Neu | | SIS488DN-T1-GE3 Original | SIS488DN-T1-GE3 garantiert | SIS488DN-T1-GE3 RFQ | SIS488DN-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited